



(51) МПК

C23C 14/02 (2006.01)*C23F* 4/00 (2006.01)*B08B* 3/10 (2006.01)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(21)(22) Заявка: 2012131801/02, 24.07.2012

Приоритет(ы):

(22) Дата подачи заявки: 24.07.2012

(43) Дата публикации заявки: 10.02.2014 Бюл. № 4

Адрес для переписки:

197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 5,
СПбГЭТУ, патентный отдел, Е.А. Ивановой

(71) Заявитель(и):

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Санкт-
Петербургский государственный
электротехнический университет "ЛЭТИ"
им. В.И. Ульянова (Ленина)" (RU)

(72) Автор(ы):

Барченко Владимир Тимофеевич (RU),
Гончаров Вадим Дмитриевич (RU),
Лисенков Александр Аркадьевич (RU),
Репеева Дарья Михайловна (RU)

(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ДУГОВЫМ РАЗРЯДОМ В ВАКУУМЕ**(57) Формула изобретения**

Способ обработки поверхности изделий дуговым разрядом в вакууме, осуществляемый катодными пятнами дугового разряда, горящего в режиме возрастающего участка вольтамперной характеристики, между анодом и катодом, который является обрабатываемой поверхностью, отличающийся тем, что для локализации области существования катодных пятен на обрабатываемой поверхности применяют анод с минимально допустимой площадью токоприемной поверхности, устанавливаемый на расстоянии от катода, обеспечивающем положительное анодное падение напряжения, при этом смещение области локализации катодных пятен осуществляют путем перемещения анода со скоростью, определяющей предельно допустимые тепловые нагрузки поверхности обрабатываемого изделия.

RU 2012131801 A

RU 2012131801 A